

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公開番号】特開2005-311328(P2005-311328A)

【公開日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2005-043

【出願番号】特願2005-81271(P2005-81271)

【国際特許分類】

H 01 L 29/786 (2006.01)

G 09 F 9/00 (2006.01)

G 09 F 9/30 (2006.01)

H 05 B 33/10 (2006.01)

H 01 L 51/50 (2006.01)

H 01 L 21/336 (2006.01)

【F I】

H 01 L 29/78 6 2 3 A

G 09 F 9/00 3 3 8

G 09 F 9/30 3 3 8

H 05 B 33/10

H 05 B 33/14 A

H 01 L 29/78 6 1 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成20年3月13日(2008.3.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】発光装置の製造方法

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

発光素子を駆動するためのトランジスタを作製する工程を有し、

前記トランジスタは第2の半導体層と、絶縁層と、導電層とが順に積層して成り、

前記工程において、

格子状の第1の半導体層を基板上に形成すると共に、

前記第1の半導体層の間に、島状に分離した前記第2の半導体層を複数形成する工程を含むことを特徴とする発光装置の製造方法。

【請求項2】

発光素子を駆動するためのトランジスタを作製する工程を有し、

前記トランジスタはシリコン層により形成された第2の半導体層と、絶縁層と、導電層とが順に積層して成り、

前記工程において、

格子状のシリコン層により形成された第1の半導体層を基板上に形成すると共に、

前記第1の半導体層の間に、島状に分離した前記第2の半導体層を複数形成する工程を含むことを特徴とする発光装置の製造方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2に記載の発光装置の製造方法において、前記第1の半導体層に不純物を添加する工程を含むことを特徴とする発光装置の製造方法。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか一に記載の発光装置の製造方法において、前記導電層は、前記絶縁層を覆うように形成した後、ドライエッティングにより加工されることを特徴とする発光装置の製造方法。